

応用物理学会 薄膜表面・物理分科会 Controlled growth and characterization 研究会プログラム

場所:名古屋大学 VBL ベンチャーホール

日時:2024年3月29日(金)13:40 - 2024年3月30日(土)12:20

参加費:無料 (分科会会員特典:分科会会員にのみ最初に案内して、次に一般の方に案内)

定員:50人

3月29日

13:40-14:00 受付

14:00-14:05 開会

14:05-14:40 SiC 表面反応の考察に基づく MOS 界面特性の制御

喜多浩之 (東京大学 新領域創成科学研究科物質系専攻)

14:40-15:15 表面科学的手法によるエピタキシャル二次元材料の構造・電子状態評価

高村(山田) 由起子 (北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科)

15:15-15:35 休憩

15:35-16:10 成長核制御による特殊薄膜の成長とその熱電特性

中村芳明 (大阪大学 大学院基礎工学研究科)

16:10-16:45 脂質二分子膜と基板表面との相互作用

住友弘二 (兵庫県立 大学大学院工学研究科)

16:45-17:20 半導体薄膜形成に対する計算科学的アプローチ

秋山亨 (三重大学 大学院工学研究科)

17:20-17:40 自由討論

17:40-17:45 挨拶

3月30日

9:40-9:55 受付

9:55-10:00 挨拶

10:00-10:35 機能性材料の保護と高度化を両立させる二次元物質コーティング

小川修一 (日本大学生産工学部)

10:35-11:10 原子間力顕微鏡による熔融金属中合金結晶成長過程の原子スケール

その場観察

一井 崇 (京都大学 大学院工学研究科)

11:10-11:25 休憩

11:25-11:55 減圧 CVD による Si 量子ドットの自己組織化形成

牧原克典 (名古屋大学大学院 工学研究科)

11:55-12:15 自由討論

12:15-12:20 閉会

世話人: 住友弘二(兵庫県大), 中村芳明(大阪大学)